

高等学校教学用書

电 学 原 理

下 册

伊·耶·塔姆著

人民教育出版社

·高等学校教学用書



电 学 原 理
下 册

伊·耶·塔姆著
錢尚武 赵祖森譯

人民教育出版社

本书原系根据苏联技术理論书籍出版社(Гостехиздат)出版的伊·耶·塔姆(И. Е. Тамм)著“电学原理”(Основы теории электричества)1949年版譯出。中譯本分訂为上下两册，于1953年起出过几版，譯者是錢尚武、赵祖森两同志。在修訂本出书前，又經赵祖森同志根据1957年版作全面的修訂。原书曾經苏联高教部审定为綜合大学教学参考书，可供我国高等学校参考。

电 学 原 理

下 册

伊·耶·塔 姆 著

錢尚武 赵祖森譯

北京市书刊出版业营业許可証出字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

上海市印刷五厂印装

新华书店上海发行所发行

各地新华书店 经售

統一书号 13010·496 开本 850×1168 1/32 印张 9.9/16
字数 252,000 印数 38,501—40,500 定价(4) 0.90
1958年8月新1版

1960年5月第2版(修订本) 1961年11月上海第5次印刷

下册 目录

第五章 磁质(可以磁化的媒质)	275
§ 60. 磁质的磁化。分子电流和传导电流	275
§ 61. 有磁质时磁场的矢势。体分子电流和面分子电流的平均密度	279
§ 62. 磁质中宏观磁场的微分方程式。磁质中的磁场强度和磁感应矢量	284
§ 63. 磁化强度和磁场强度的关系。顺磁质。反磁质和铁磁质	287
§ 64. 恒定电流场的完整方程式组。均匀磁媒质	290
§ 65. 电流在磁场中受到的机械力。电流的相互作用	292
§ 66. 磁质在磁场中受到的有质动力	296
§ 67. 磁质中磁场宏观方程式推导的补充	298
§ 68. 磁质磁化的机构。拉莫定律	302
§ 69. 反磁性	307
§ 70. 顺磁性	309
§ 71. 磁化理论的精确表述和补充。自旋的作用。回转磁现象	314
§ 72. 铁磁性。樊依斯分子场	319
§ 73. 理想铁磁质中场的方程式(通常的方案)。永久磁体	328
§ 74. 理想铁磁质中场方程式的另一种方案。电流和永久磁体的等效性	334
§ 75. 永久磁体在外磁场中受到的有质动力	342
第六章 似稳电磁场	347
§ 76. 运动导体中的电流感应	347
§ 77. 电磁感应定律。可变电流的欧姆定律	352
§ 78. 似稳电流。可变电流的微分方程式	356
§ 79. 可变电流场中的能量转换。电流的磁相互作用能。楞次定则	359
§ 80. 可变电流理论最简单的应用。变压器	364
§ 81. 磁场的能量。感应系数的能量意义	372
§ 82. 顺磁质和反磁质磁化时能的转换。磁场的自由能	379
§ 83. 从能量表示式决定磁场的有质动力	383
§ 84. 磁场的张力张量	388
§ 85. 电场的旋度	391
§ 86. 电压和积分路程的关系。可变电流的电压	394
§ 87. 連續性方程式	399
§ 88. 位移电流	401

§ 89. 似稳电流綫路中的电容器。电振蕩	407
§ 90. 趋肤效应	413
第七章 靜止媒質中的可变电磁場和它的傳播。电磁波	421
§ 91. 宏觀电磁場的麦克斯韦方程組	421
§ 92. 坡印亭定理。能流	427
§ 93. 麦克斯韦方程式解答的唯一性	433
§ 94. 电磁場勢的微分方程式	436
§ 95. 波动方程式和达朗贝尔方程式的解	440
§ 96. 推迟势与超前势。規范不变性	447
§ 97. 电磁扰动的傳播速度。似稳条件	455
§ 98. 振动子。振动子場的推迟势	459
§ 99. 振动子的場。它的辐射	468
§ 100. 光的电磁本性。电介质中的平面波	478
§ 101. 平面波在电介质中的反射和折射	484
§ 102. 波在导电媒质中的傳播。光从金属表面上的反射	493
§ 103. 光压力。电磁場的動量	498
§ 104. 电磁动量矩。靜場的特殊情形	505
§ 105. 电磁場的張力張量和有質動力	510
§ 106. 非似稳电流的实例。沿电缆的波	515
§ 107. 迅变电流的近似理論。“电报員方程式”	524
§ 108. 铁磁質的自由能。磁滞	529
§ 109. 近作用理論和远作用理論概述	535
第八章 緩慢运动媒質中的电磁現象	540
§ 110. 运动媒質中場的微分方程式	540
§ 111. 对流自流。运动媒質的电极化强度和磁化强度	545
§ 112. 运动导体中的欧姆定律和电磁感应。单极感应	552
§ 113. 在电磁場中运动的电介质	558
§ 114. 运动电介质中光的傳播。費涅耳曳引系数。从运动鏡上的反射	561
§ 115. 計算系統的变换。电場和磁場之間差别的相对性质	565
习題解答	1

第五章 磁質(可以磁化的媒質)

§ 60. 磁質的磁化。分子电流和傳导电流

1. 正象把电介质放入自由电荷(見 § 21 这一术语的定义)的場中时由于其极化而引起此場的改变一样,把磁質(例如鐵)放入电流的磁場中时,由于本身的磁化也要引起这一磁場的改变。这里磁質是指一切能够磁化的物体^①,換句話說,所有的物体,只要它的存在能使磁場的形状发生变化或激起磁場,都叫做磁質。一切电介质随着外电場的消失而退极化^②,然而,只有大多数磁質在外磁場的作用下磁化,并且在外磁場消失时完全退磁(順磁質和反磁質的暫時磁化或感应磁化)。此外,和电介质不同,有一类磁質(所謂鐵磁質)即使在外磁場消失之后也仍然保持它的磁化(所謂永久磁化或剩磁化),也就是它的存在不仅能使电流的磁場变形,而且能独立激发磁場,而不管有没有电流存在(所謂永磁体)^③。

① 實質上所有的物体都具有或多或少的磁性(固然在多数情形下表現得很弱)。

② 見 § 22 上册 101 頁,在某些电介质中,特别是在介質混有外来杂质的情形下,发生的所謂剩余电极化現象,按其物理本性來說与鐵磁質的剩余磁性沒有絲毫共同的地方。剩余电极化是由于漏电流和极化电流的出現(不良絕緣体)使自由电荷重新分布引起的。热電現象和鐵電現象(見 § 29 上册 129 頁)是例外,它們的电介质的性质在許多方面的确和鐵磁質的磁性相似。

③ 鐵磁質保持剩余磁化的能力主要是因为它們的微观不均匀性(剩余彈性应变,多晶结构,化学不純),例如在沒有内应变的鐵磁单晶体中几乎就完全缺乏这种性能。因而,严格說来,鐵磁質的基本特性不是剩余磁性(磁滯),而是磁化强度和磁場强度关系的非綫性(关于这一点詳見 §§ 72 和 108),这种性质甚至在很弱的場中也顯現出来,而在鐵磁質微观不均匀性增加时表現得愈发显著。

2. 磁化了的磁質的場，和任何的磁場一样，是由磁質內环流着的电流造成的^①。

我們首先来研究不导电的、由中性分子(气体、液体)或者由紧縛于一定位置的离子(离子晶体点陣或非晶固体电介质)构成的磁質。虽然在这种媒質中平均电流密度等于零，电荷不能在其中移动一宏观距离，然而在各个分子或离子内部有和某种电流分布相当的电子运动。这些电流称为分子电流；在未磁化的磁質中它們完全杂乱无章地分布着，因而它們的磁場平均說來彼此抵消。但磁化了的磁質中分子电流的分布是有規則的，因而这些电流的合磁場不等于零。

在能传导电流的磁質(金属、电解溶液之类)中显然必須区分傳导电流 $j_{\text{傳導}}$ 及分子电流 $j_{\text{分子}}$ ，前者和运送宏观电流的电荷(金属中的自由电子，电解溶液中的离子和离子化气体中的离子)之运动相当，后者存在于电解溶液的中性分子、构成金属坚固結晶架子的紧縛着的离子等等内：

$$j_{\text{微观}} = j_{\text{傳導}} + j_{\text{分子}}, \quad (60.1)$$

式中指标“微观”表示媒質中真正的电流微观密度，以別于平均宏观密度 j 。

虽然并不一定可以确切地将电流分成两类^②，但是因为这种区分使得从电子論的概念来推导場的宏观方程式的方法大为简化，我們將保留这一分类^③。为了做到这一点，只要假定，分子电流和傳导电流有所不同，它是封閉在微观的微小空間容积內的。

3. 要建立磁質的理論，首先就必須用适当的方法定量地表征媒質中分子电流的分布。分子电流密度 $j_{\text{分子}}$ 在物理无限小范围内的平均

① 电子的自旋磁矩也可以归結为相应电流的作用(見本节末)。

② 例如自由电子在金属中造成的电流一般說來不能整个归入傳导电流內，因为，例如金属的磁化主要是由自由电子的序化运动引起的，而和宏观电流的轉移无关。

③ 当然，論証場的宏观方程式的正确性也可以不需要这种特殊假定(見 § 91末)。

值不能作为这样的表征。因为，那怕閉合电流組的磁矩和磁場决不是一定等于零，但电流在这一电流組的整个範圍內的平均值却是等于零的^①。特别是在任一分子中流着的諸电流的矢量和恒等于零。

在 §§ 56 和 57 中我們見到，閉合电流組在大小充分小的条件下，可以单用它的磁矩表征出来：

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2c} \int [\mathbf{R} \mathbf{j}] dV.$$

显然，分子电流的分布也應該用它們的磁矩表征出来。正如等于单位体积电介质电矩的电极化强度矢量 \mathbf{P} 作为电介质电极化的量度一样，等于单位体积磁質分子电流磁矩的磁化强度矢量 \mathbf{I} 就作为磁質磁化的量度：

$$\mathbf{I} = \frac{1}{2c} \int [\mathbf{R} \mathbf{j}_{\text{分子}}] dV, \quad (60.2)$$

式中积分遍及单位体积磁質。在 § 57 中已經指出过，如果电流組是閉合的，这一积分的值就和矢徑 \mathbf{R} 起点的选择无关。

如果磁質由单个分子所組成（例如，气态的磁質），那么它的磁化强度 \mathbf{I} 也可以定义为单位体积磁質內分子的磁矩的矢量和：

$$\mathbf{I} = \sum \mathbf{M}, \quad (60.3)$$

式中 \mathbf{M} 表示磁質单个分子的磁矩。不难理解，在由单个分子构成的磁質中，方程式(60.3)和方程式(60.2)等效。

最后，如果磁質的磁化在磁質各部分并不是一样的，那么磁化强度矢量 \mathbf{I} 可以定义成分子电流磁矩的（对物理无限小体积 dV 的）平均密度：

$$\mathbf{I} = \frac{1}{2c} [\mathbf{R} \mathbf{j}_{\text{分子}}] = \frac{1}{2c \Delta V} \int_{\Delta V} [\mathbf{R} \mathbf{j}_{\text{分子}}] dV. \quad (60.4)$$

仿照电极化强度 \mathbf{P} ，磁化强度 \mathbf{I} 也可以称为磁极化强度。

^① 因为根据 § 57 中的証明，从(57.7)可得到(57.6)。

4. 以研究恒定閉合分子电流为基础去建立磁質理論可能引起两种怀疑。

首先,从关于原子构造的初步概念这种观点来看,原子内部和分子内部电子的运动并不完全和恒定电流相当,因为电子的場不是恒定不变的,而是和电子繞其轨道(环绕原子核或者沿着分子内复杂的轨道等等)轉动的周期相应,在周期性地变化着的。

从波尔原子理論的观点看来,这一困难是可以消除的,这是因为电子沿轨道轉动的周期非常小,可以和光振动周期(10^{-14} — 10^{-15} 秒)相比拟,因而在作宏观的观察时,我們覺察的只是此場的时间平均值。因此,在建立宏观理論时,我們可以用恒定閉合电流(“分子电流”)来代替原子内运动的电子,假如这种分子电流的恒定場和电子場在一周期時間內的平均值相同的話。

然而近代的量子力学完全消除了这一困难,它表明,电子在原子内沿一定轨道运动这种直观的概念只是实际情形的十分粗略的第一次近似,并表明处在稳定态的原子的磁场是恒定的,且可以归結为(以一定密度 j 分布在原子或分子中的)恒定閉合电流的場。

其次,还可以引起怀疑的是,原子和分子的磁性不仅决定于其中电子的运动,并且还决定于电子的自旋。的确,电子的自旋磁矩常常比拟成磁偶极子。然而,在 § 58 中已經指出过,按照量子力学,由电子自旋磁矩激起的磁场也可以归結为以一定方式分布在空間中的电流的場。

无论如何,和任一电流場一样,自旋激发起的磁场是渦旋場,它應該用矢势 A 来表示,而不用标势 ψ 来表示(見 § 71)。

因此,磁質的磁性是由分子电流所引起的这一斷言获得确証。然而,为了某些目的,最好将磁化强度 I 看成由两部分合成的,一部分是和电子的平动(轨道运动)相当的电流的磁矩,另一部分是电子的偶极自旋磁矩。这样的区分絲毫不改变以下几节中的討論(用来推导磁質內磁场的普遍方程式),但对研究回轉磁效应(§ 71)和鐵磁質磁化的机

構(§72)很有用。

§ 61. 有磁質時磁場的矢勢。體分子電流 和面分子電流的平均密度

1. 按照(60.1), 將任意媒質中的總密度 $\mathbf{j}_{\text{微觀}}$ 分成導電密度 $\mathbf{j}_{\text{導電}}$ 和分子電流密度 $\mathbf{j}_{\text{分子}}$, 我們就得到磁場矢勢的下列表示式:

$$(61.1) \quad \mathbf{A} = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_{\text{微觀}} dV}{R} = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_{\text{導電}} dV}{R} + \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_{\text{分子}} dV}{R}.$$

用 \mathbf{A}_0 和 \mathbf{A}' 表示導電密度和分子電流的矢勢

$$\mathbf{A}_0 = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_{\text{導電}} dV}{R}, \quad \mathbf{A}' = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_{\text{分子}} dV}{R}, \quad (61.1)$$

就可以寫出:

$$(61.2) \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}'.$$

在這些表示式中包含有電流的真實微觀密度, 而在宏觀的理論中我們應當運用微觀量的平均值, 因而應該將表示式(61.1)作相應的變換。

$\mathbf{j}_{\text{導電}}$ 在物理無限小體積內的平均值顯然是電流密度 \mathbf{j} :

$$(61.3) \quad \mathbf{j} = \bar{\mathbf{j}}_{\text{導電}},$$

只有不是公開地考慮到分子電流的宏觀理論才運用它。因此, 在宏觀理論中, 我們可以在 \mathbf{A}_0 的表示式中直接以 \mathbf{j} 代替 $\mathbf{j}_{\text{導電}}$:

$$(61.4) \quad \mathbf{A}_0 = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j} dV}{R}.$$

據此, 要決定分子電流矢勢 \mathbf{A}' 的平均值, 就應該以宏觀理論所運用的量, 亦即磁化強度, 來表示分子電流密度的平均值 $\mathbf{j}_{\text{分子}}$ 。然而以下面的方法直接算出矢量 \mathbf{A}' 的平均值比較簡單。

閉合電流組的矢勢在它的空間大小充分小的條件下, 按照(57.8), 等於 $[MR]/R^2$, 式中 M 是電流組的磁矩。另一方面, 按照(60.2)和

(60.4), 表征磁质内分子电流的、磁质体积元 dV 的磁矩等于 $\mathbf{I}dV$ ^①。因此, 磁质体积元 dV 所激发的场的矢势等于

$$\frac{[\mathbf{IR}]}{R^3} dV,$$

式中 \mathbf{R} 是从体积元 dV 作到决定矢势值的那一“观察点”的矢径。

最后, 在所有磁质元中环流着的全体分子电流的矢势 \mathbf{A}' 由下列积分来决定:

$$\mathbf{A}' = \int \frac{[\mathbf{IR}]}{R^3} dV, \quad (61.5)$$

这一积分显然可以遍及整个的无限空间(因为在磁质的外部 $\mathbf{I}=0$)。因此, 分子电流场的矢势 \mathbf{A}' 完全决定于媒质的磁化强度 \mathbf{I} 。

2. 我们将上一表示式适当地稍加改写。按照方程式 (48₃^{*}) 和 (10^{*}),

$$\text{rot}_q \left(\frac{1}{R} \mathbf{I} \right) = \left[\nabla_q \frac{1}{R} \cdot \mathbf{I} \right] + \frac{1}{R} \text{rot } \mathbf{I} = \frac{[\mathbf{RI}]}{R^3} + \frac{1}{R} \text{rot } \mathbf{I}^{\circledast},$$

因此, 上一方程式可以写成:

$$\mathbf{A}' = \int \frac{\text{rot } \mathbf{I}}{R} dV - \int \text{rot}_q \left(\frac{1}{R} \mathbf{I} \right) dV.$$

借助于矢量分析中的关系式 (56^{*}), 后一积分可以变换成为沿着包含积分体积 V 的表面 S 的积分^③:

$$\int_V \text{rot}_q \left(\frac{1}{R} \mathbf{I} \right) dV = \oint_S \frac{[\mathbf{nI}]}{R} dS.$$

如果在场中没有磁化强度矢量 \mathbf{I} 的突变面, 那么后一积分可以沿着包含整个场的无限远的表面去积, 这时它就变为零(如果磁化强度在

① 我们要指出, 磁化强度矢量 \mathbf{I} 是宏观的量, 因为, 按照 (60.4), 它等于物理无限小体积内磁矩的平均密度。

② 在表示式 $\text{rot}_q \mathbf{I}$ 中的指标 q 可以略去而不怕误解, 因为矢量 \mathbf{I} 只是矢径 \mathbf{R} 源点的函数。

③ 这一变换可以直接应用到我们的积分上, 因为在求空间微商时, 我们将 R 和 \mathbf{I} 按矢量 \mathbf{R} 源点(和积分体积元 dV 重合)的坐标去求微商(见 § 21 上册 96 页的注)。

无限远处消失得比 $\frac{1}{R}$ 为快的話)。

不然的話, 面积分还應該象平常那样还要扩展在 S'_1 面上, S'_1 是把矢量 \mathbf{I} 的突变面 S_1 从积分体积 V 中划分出来的曲面。

緊縮 S'_1 面直到它和突变面 S_1 重合, 重复(只有很少的改变)我們在 § 12 中所作的討論, 就得到

$$\lim \oint_{S'_1} \frac{[\mathbf{n} \cdot \mathbf{I}]}{R} dS = \int_{S_1} \frac{[\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{I}_1] + [\mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{I}_2]}{R} dS = - \int_{S_1} \frac{[\mathbf{N} \cdot \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1]}{R} dS,$$

式中 \mathbf{I}_1 和 \mathbf{I}_2 是 \mathbf{I} 在突变面两侧的值, 而 \mathbf{N} 是此面上的法線, 从 1 指向 2。以 \mathbf{n} 表示这一法線, 就得到:

$$\mathbf{A}' = \int \frac{\text{rot } \mathbf{I}}{R} dV + \int \frac{[\mathbf{n} \cdot \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1]}{R} dS. \quad (61.6)$$

因此, 任意媒質中磁场的全矢勢 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}'$ 在宏观理論中以宏观电流密度 \mathbf{j} 及表征媒質磁化的矢量 \mathbf{I} 来表示:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}}{R} dV + \int \frac{\text{rot } \mathbf{I}}{R} dV + \int \frac{[\mathbf{n} \cdot \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1]}{R} dS. \quad (61.7)$$

8. 这一表示式是从 \mathbf{A}' 的微观表示式 (61.1) 用直接取它的平均值的方法, 亦即在 (61.1) 中以微观电流密度 $\mathbf{j}_{\text{分子}}$ 在物理无限小体积内的平均值 $\bar{\mathbf{j}}_{\text{分子}}$ 来代替 $\mathbf{j}_{\text{分子}}$ 时可得到, 表示式:

$$\mathbf{A}' = \frac{1}{c} \int \frac{\bar{\mathbf{j}}_{\text{分子}} dV}{R}. \quad (61.8)$$

把这个式子和分子电流矢勢 \mathbf{A}' 的宏观表示式 (61.6) 相比較, 这一比較首先就指明, 体分子电流的平均密度 $\bar{\mathbf{j}}_{\text{分子}}$ 和媒質的磁化强度有如下的联系:

$$\bar{\mathbf{j}}_{\text{分子}} = c \text{rot } \mathbf{I}; \quad (61.9)$$

其次, 从这一比較中得到結論, 磁化强度矢量突变面的存在这一假定相当于假定除了体分子电流外还有面分子电流, 面分子电流的平均密度和 \mathbf{I} 的面旋度成正比:

$$\bar{\mathbf{j}}_{\text{分子}} = c \text{Rot } \mathbf{I} = c [\mathbf{n} \cdot \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1]. \quad (61.10)$$

的确，在这一假定下，表示式(61.8)必須补充以考虑到面电流的这一項：

$$\mathbf{A}^r = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_{分子}}{r^2} dV + \frac{1}{c} \frac{\mathbf{i}_{分子}}{R} dS,$$

因而，根据(61.9)和(61.10)这一表示式和(61.6)等效。

当然，物理量突变面和面电流存在的可能性这一假定是場的宏观解釋的特征，而和微观理論完全是背道而驰的。

正如我們所預料的，表示分子电流平均密度的公式(61.9)滿足电流閉合的条件，因为，按照(42₂^{*})

$$(8.18) \quad \operatorname{div} \bar{\mathbf{j}}_{分子} = c \operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{I} = 0.$$

其次，分子电流平均面密度的表示式和从体密度表示式用(49.7)类型的极限过渡法所能得到的公式相同。

我們要指出，按照方程式(61.9)，在均匀磁化的媒質中(\mathbf{I} =恒量)，分子电流的平均密度等于零^①。这是因为，如果媒質的相邻体积元的磁化是完全相同的，那么在媒質中决不会发生电流在某一确定方向占优势的情形。而在磁化后的媒質和真空的接界处，按照方程式(61.10)，具有密度为 $i = \pm c[n\mathbf{I}]$ 的面电流，这是因为在真空中 $\mathbf{I} = 0$ 。

将分子电流的分布和磁化强度矢量的空间微商(以及它的切向分量在突变面上的突变)联系起来的方程式(61.9)和(61.10)，我們是用很迂回的方法得到的。希望直接从基本方程式(60.2)(这个方程式定出磁化强度矢量 \mathbf{I} 并以 $\mathbf{j}_{分子}$ 表示 \mathbf{I} 的值)得到它們。在 § 67 中，我們在某些使問題簡化的假定下去进行这一計算。

(8.18) 4. 我們来研究在整个体积中平行于軸綫发生均匀磁化的圓柱形磁体作为例子。体分子电流的平均密度到处等于零，因为在 \mathbf{I} =恒量时， $\operatorname{rot} \mathbf{I} = 0$ 。在圓柱的两底上也没有面分子电流，因为在这两底面上法綫平行于 \mathbf{I} 。在圓柱側面上法綫垂直于 \mathbf{I} ，因此在圓柱側面上

① 和均匀极化电介质中束缚电荷的平均密度等于零相似。

分子电流将不为零，分子电流之值等于

$$i_{\text{分子}} = cI \quad (61.11)$$

[在公式(61.10)中，我們令 $I_1 = I$, $I_2 = 0$ ，因为在磁体外部 $I = 0$]

这些圆形闭合面电流和磁化强度 I 的方向組成右螺旋系統。

因此；从电子論的觀点看来，磁体相当于圓柱形无散电流(見 § 49)。

同时从方程式(61.11)和方程式(49.14)的比較中得到結論，和該磁体相当的螺綫管中的电流强度 J 可以用下列等式来决定：

$$i = nJ = cI, \quad (61.12)$$

式中 n 是螺綫管单位长度的綫繩数。在磁质和真空的交界处面电流的产生可以用很简单的討論來說明。图 63 十分概略地表示磁体的橫截面。磁体内部全体分子电流可以概略地表示成在同一方向(例如逆时針方向)周流磁体每一細胞(分子)的、强度相同的电流的总合。磁体内部相邻分子的电流相互抵消，但在磁体的表面上它们組成沿磁体边界环繞着的圆形电流^①。

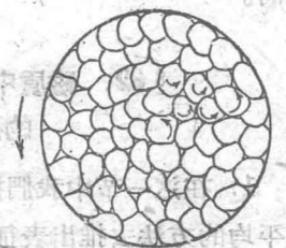


图 63.

为要使这一討論在量的方面更加精确，我們来研究包含在垂直于圓柱軸的两平面間的磁体薄层。如果这一薄层的高度等于 l ，截面等于 S ，体积 $V = lS$ ，而薄层内各分子的磁矩之和等于 $\sum \mathbf{M}$ ，那么

$$\mathbf{I} = \frac{1}{V} \sum \mathbf{M}.$$

利用方程式(56.2)，以各該分子电流的强度和面积来表示每一分子的磁矩，就得到：

$$\mathbf{I} = \frac{1}{cV} J \sum \mathbf{S},$$

^① 关于磁体内部的場和等效螺綫管内部的場之区别这一問題将在 § 74 中加以研究。

為簡便計，我們假定式中所有分子电流都是綫电流，而且它們的强度都相同。如果我們改變分子电流的强度 J 和面積而使它們的乘积保持不变，分子的磁矩就不会改变。按照图 63 选择这些量，使得相邻的分子电流彼此緊貼。这时 ΣS 数值上等于磁体的截面积 S ，而

$$I = \frac{JS}{cV} = \frac{JS}{cSl} = \frac{1}{c} \frac{J}{l}.$$

按定义在所研究薄层表面上流动的电流的强度 J 和此层高度 l 之比，等于电流的面密度 i 。因此，上一方程式和方程式(62.11)及(61.12)相同。

§ 62. 磁質中宏观磁场的微分方程式。磁質中的磁场强度和磁感应矢量

1. 在这一节中我們提出这样一个問題，即用将真实微观場方程式平均的方法去推出表征場的量 H 和 j 这些平均的宏观值的方程式。同时我們以一个假定为出发点，即假定对于真实的微观場來說如果将 $j_{\text{微观}}$ 了解成場中該点电流密度的真实“微观”值，则恒定电流磁场的基本方程式(47.1)和(47.3)：

$$\operatorname{div} \mathbf{H}_{\text{微观}} = 0 \text{ 和 } \operatorname{rot} \mathbf{H}_{\text{微观}} = \frac{4\pi j_{\text{微观}}}{c},$$

是严格正确的。但我們的問題是要找出一个用来确定矢量 $\mathbf{H}_{\text{微观}}$ 在物理无限小体积內的平均宏观值(这一平均值我們用 $\bar{\mathbf{H}}_{\text{微观}}$ 来表示)的方程式(見 § 25)。因为，按照方程式(25.2)，对坐标的微商的平均值等于被微商量的平均值的微商，所以从場的微观方程式得到下列結論：

$$\operatorname{div} \bar{\mathbf{H}}_{\text{微观}} = 0, \quad (62.1)$$

$$\operatorname{rot} \bar{\mathbf{H}}_{\text{微观}} = \frac{4\pi \bar{j}_{\text{微观}}}{c}. \quad (62.2)$$

按照(60.1)，任意媒質中的电流密度由传导电流及分子电流所組成。按照(61.3)， $j_{\text{微观}}$ 的平均值是导体中通常的宏观电流密度 j ，而平均值

$\bar{j}_{\text{分子}}$, 按照(61.9), 可以用磁化强度的旋度来表示。因此,

$$\bar{j}_{\text{宏观}} = \bar{j}_{\text{净}} + \bar{j}_{\text{分子}} = \mathbf{j} + c \operatorname{rot} \mathbf{I}。 \quad (62.3)$$

将此式代入(62.2)中, 就得到:

$$\operatorname{rot} \bar{\mathbf{H}}_{\text{宏观}} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + 4\pi \operatorname{rot} \mathbf{I}。 \quad (62.4)$$

方程式(62.1)和(62.4)是任意磁媒質中磁場的基本微分方程式。

2. 按定义, 宏观电场的强度等于微观电场强度 $\mathbf{E}_{\text{微观}}$ 的平均值。用相似的方法去定义宏观磁场强度是完全自然的。

然而在历史上根深蒂固的倒是另一种规定方法, 这种规定从分子中存在有磁荷这一概念的观点看来是十分自然的(见 § 73); 即, 磁质中宏观场的强度(这一强度我们今后就以字母 \mathbf{H} 来表示)由下列关系来决定:

$$\mathbf{H} = \bar{\mathbf{H}}_{\text{宏观}} - 4\pi \mathbf{I}。 \quad (62.5)$$

而微观场强度的平均值称为磁感应强度矢量而以字母 \mathbf{B} 来表示:

$$\mathbf{B} = \bar{\mathbf{H}}_{\text{宏观}}。 \quad (62.6)$$

方程式(62.4)可以写成如下:

$$\operatorname{rot}(\bar{\mathbf{H}}_{\text{宏观}} - 4\pi \mathbf{I}) = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}，$$

因此用新的符号来写它具有下列形式:

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}， \quad (62.7)$$

而方程式(62.1)和(62.5)具有下列形式:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0， \quad (62.8)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi \mathbf{I}。 \quad (62.9)$$

方程式(62.7), (62.8)和(62.9)是一组场的基本微分方程式, 只要以联系磁化强度 \mathbf{I} 和磁場强度 \mathbf{H} 的方程式补充进去就可以了。这些量之间的联系我们将下一节中加以研究。在没有磁化媒質的情形下 $\mathbf{I}=0$; \mathbf{H} 和 \mathbf{B} 就没有区别, 而方程式(62.7)和(62.8)与早先推出的真

空中的磁場方程式(47.1)和(47.3)相同。

以后如果沒有相反的規定,我們將磁場強度 \mathbf{H} 了解成決定於關係式(62.5)並滿足方程式(62.7)和方程式(62.9)的矢量。

在形式上比較電場方程式和磁場方程式時:

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = 4\pi \rho, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi \mathbf{P},$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi \mathbf{I}$$

就會產生一種印象,一方面,量 \mathbf{E} 和量 \mathbf{H} 相似,另一方面 \mathbf{D} 和 \mathbf{B} 相似,而實質上,剛才已經指出過,磁感應強度 \mathbf{B} 和宏觀電場強度 \mathbf{E} 相似 (\mathbf{B} 等於微觀磁場強度的平均值),宏觀磁場強度 \mathbf{H} 和電感應強度 \mathbf{D} 相似^①。例如,這表現在電流所受的力決定於磁感應強度 \mathbf{B} 而電荷所受的力決定於電場強度 \mathbf{E} (我們在 § 65 中就會看到)這一點上。

3. 最後讓我們指出,在根深蒂固的表示法中,方程式 $\mathbf{H}_{\text{宏观}} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$ [比較方程式(46.2)](用這一方程式就可能將場強的決定歸結為矢勢的計算)可以寫成如下:

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad (62.10)$$

當然,式中 \mathbf{A} 必須了解成矢勢的平均宏觀值。方程式(62.8)可以看成方程式(62.10)的直接結果。而宏觀場強度矢量 \mathbf{H} ,一般說來,不是無散的,因而不能表示成輔助矢勢的旋度。

最後,矢勢宏觀值的微分方程式

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \vec{\mathbf{j}}_{\text{宏观}} = -\frac{4\pi}{c} (\mathbf{j} + c \operatorname{rot} \mathbf{I}) \quad (62.11)$$

可以或者由方程式(46.5)的平均,或者直接從(61.7)[用的方法和 § 46 中從(46.1)得到方程式(46.5)的方法相同]得到。

4. 至於磁場的邊界條件,則只要利用從有限厚度薄層的情形(薄

^① 這一情況特別表現在如下的一點上,在相對論中將電磁場方程式用四維空間的公式來表示時,就必須,一方面將矢量 \mathbf{E} 和 \mathbf{B} ,另一方面將矢量 \mathbf{D} 和 \mathbf{H} 成對地結合在兩個四維的二級張量中[比較方程式(117.7)]。